

통제번호	개정 전	개정 후
1	<p>공작기계(machine tools)와 이를 위한 부품(components) 및 수치제어장치(numerical controls)로서 다음 중 하나의 것</p> <p>a. 연삭가공 공작기계로서 한 개 이상의 직선축의 모든 가능한 보정 후 위치결정 정확도(정밀도)가 ISO 230/2(1988)이나 국내 동등 규격에 따라 15 μm 이하(같거나 더 우수한)인 것 주: 본 규정은 별표 2의 2B201.b, 2B001.c에서 통제하고 있는 연삭가공 공작기계에 대해서는 적용되지 않는다.</p> <p>b. 별표 2의 2B001, 2B201, 또는 a항에 의해 통제되는 공작기계를 위해 “전용설계”된 부품(components) 및 수치제어장치(numerical controls)</p>	<p>공작기계(Machine tools)와 이를 위한 부품(Components) 및 수치제어장치(Numerical controls)로서 다음 중 하나의 것</p> <p>a. 연삭가공 공작기계로서 한 개 이상의 직선축의 모든 가능한 보정 후 위치결정 정확도(정밀도)가 ISO 230/2(1988)이나 국내 동등 규격에 따라 15 μm 이하(같거나 더 우수한)인 것 주: 본 규정은 별표 2의 2B201.b, 2B001.c에서 통제하고 있는 연삭가공 공작기계에 대해서는 적용되지 않는다.</p> <p>b. 별표 2의 2B001, 2B201, 또는 a항에 의해 통제되는 공작기계를 위해 “전용설계”된 부품(Components) 및 수치제어장치(Numerical controls)</p>
3	<p>치수(dimension)/ 변위(displacement) 측정기</p>	<p>치수(Dimension)/ 변위(Displacement) 측정기</p>
3의2	<p>별표 2의 2B116에서 통제하지 않는 진동시험시스템, 장비와 그 부품으로서 다음 중 하나의 것</p> <p>a. 피드백 또는 폐쇄회로 기법을 사용하고 디지털 제어기를 가진 진동시험시스템으로서, ‘bare table’ 측정에서 주파수 범위 0.1 Hz ~ 2 kHz 사이의 전 영역에서 0.1g rms 이상의 가속도로 진동시킬 수 있고, 50 kN 이상의 힘을 전달할 수 있는 것</p> <p>b. 디지털 제어기로서 “전용설계”된 진동시험 소프트웨어를 장착하고 실시간 대역폭(bandwidth)이 5 kHz 초과이며 a항에 제시된 진동시험시스템과 함께 사용하기 위해 설계된 것</p> <p>c. 가진기(vibration thruster)로서 증폭기 장착여부에 관계없이 피진동체에 미치는 힘이 ‘bare table’ 측정에서 50 kN 이상으로 a.항의 진동시험시스템에 사용할 수 있는 것</p> <p>d. 시험체 지지구조물(test piece support structures) 및 전자장치로서 다수의 가진기를 결합하여 ‘bare table’ 측정에서 유효결합력 50 kN 이상을 가할 수 있는 완전한 가진 장치를 구성할 수 있도록 설계된 것으로서 a항의 진동시험시스템에 사용가능한 것</p> <p>기술해설:</p>	<p>별표 2의 2B116에서 통제하지 않는 진동시험시스템, 장비와 그 부품으로서 다음 중 하나의 것</p> <p>a. 피드백 또는 폐쇄회로 기법을 사용하고 디지털 제어기를 가진 진동시험시스템으로서, ‘Bare table’ 측정에서 주파수 범위 0.1 Hz ~ 2 kHz 사이의 전 영역에서 0.1g rms 이상의 가속도로 진동시킬 수 있고, 50 kN 이상의 힘을 전달할 수 있는 것</p> <p>b. 디지털 제어기로서 “전용설계”된 진동시험 소프트웨어를 장착하고 실시간 대역폭(Bandwidth)이 5 kHz 초과이며 a항에 제시된 진동시험시스템과 함께 사용하기 위해 설계된 것</p> <p>c. 가진기(Vibration thruster)로서 증폭기 장착여부에 관계없이 피진동체에 미치는 힘이 ‘Bare table’ 측정에서 50 kN 이상으로 a.항의 진동시험시스템에 사용할 수 있는 것</p> <p>d. 시험체 지지구조물(Test piece support structures) 및 전자장치로서 다수의 가진기를 결합하여 ‘Bare table’ 측정에서 유효결합력 50 kN 이상을 가할 수 있는 완전한 가진 장치를 구성할 수 있도록 설계된 것으로서 a항의 진동시험시스템에 사용가능한 것</p> <p>기술해설:</p>

통제번호	개정 전	개정 후
	'Bare table'이란 고정구(fixture)나 피팅(fitting)이 없는 평평한 테이블, 또는 표면을 말한다.	'Bare table'이란 고정구(Fixture)나 피팅(Fitting)이 없는 평평한 테이블, 또는 표면을 말한다.
3의3	b. a항에서 통제하는 밸런싱 머신에 사용하기 위해 설계되거나 개조된 지시계 헤드(indicator heads)	b. a항에서 통제하는 밸런싱 머신에 사용하기 위해 설계되거나 개조된 지시계 헤드(Indicator heads)
4	판(sheet) 또는 플레이트 형태의 철강 합금으로 다음 중 하나 이상의 특성을 가지는 것	판(Sheet) 또는 플레이트 형태의 철강 합금으로 다음 중 하나 이상의 특성을 가지는 것
5	IC116 또는 IC216에서 명시한 품목을 제외한 마레이징강(maraging steel)으로 293 K (20°C)에서 '견딜 수 있는' 최대인장강도가 2,050 MPa 이상인 것	IC116 또는 IC216에서 명시한 품목을 제외한 마레이징강(Maraging steel)으로 293 K (20°C)에서 '견딜 수 있는' 최대인장강도가 2,050 MPa 이상인 것
17	제조사 규정 최대유량(상온, 상압에서)이 1 m ³ /h을 초과하는 진공펌프와 이러한 펌프를 위해서 설계된 케이싱(펌프 몸체), 미리 제작된 케이싱 라이너, 임펠러, 회전자(rotor) 또는 제트펌프 분사기로서, 처리 중인 화학물질과 직접적으로 접촉하는 모든 표면이 별표2 2B350.i에서 통제하는 접액부 소재인 것	제조사 규정 최대유량(상온, 상압에서)이 1 m ³ /h을 초과하는 진공펌프와 이러한 펌프를 위해서 설계된 케이싱(펌프 몸체), 미리 제작된 케이싱 라이너, 임펠러, 회전자(Rotor) 또는 제트펌프 분사기로서, 처리 중인 화학물질과 직접적으로 접촉하는 모든 표면이 별표2 2B350.i에서 통제하는 접액부 소재인 것
19	구성 소재에 관계없이 건조 전(wet) 또는 건조(dry)된 염소의 압축을 위해 "전용설계"된 압축기	구성 소재에 관계없이 건조 전(Wet) 또는 건조(Dry)된 염소의 압축을 위해 "전용설계"된 압축기
22	a. "마이크로프로세서 마이크로 회로", "마이크로컴퓨터 마이크로 회로" 마이크로 컨트롤러 마이크로 회로로 다음의 것:	a. "마이크로프로세서 마이크로 회로", "마이크로컴퓨터 마이크로 회로" 마이크로 컨트롤러 마이크로 회로로 다음의 것:
22	c.3. 12 bit 이상 14 bit 이하의 분해능력으로 초당 1000만 워드 이상의 출력 속도를 가지는 것; 또는	c.3. 12 bit 이상 14 bit 이하의 분해능력으로 초당 1,000만 워드 이상의 출력 속도를 가지는 것; 또는
22	f.1. 단자(terminal) 수가 144개를 초과하는 것	f.1. 단자(Terminal) 수가 144개를 초과하는 것
22	j.2. 293 K (20 °C)에서 350 Wh/kg 이하의 에너지 밀도를 갖는 '2차 셀'; 주: j항은 단일 셀 배터리를 포함하여 배터리를 통제하지 않는다. 기술해설: 1. j항에서 에너지 밀도(Wh/kg)는 공칭 전압에 공칭 용량(Ah)을 곱한 값을 질량(kg)으로 나누어 계산한다. 공칭 용량이 기재되어 있지 않을 경우에는 공칭 전압의 제공에 방전시간(h)을 곱한 값을 방전 부하(Ω)와 질량(kg)으로 나누어 계산된다. 2. j항에서 '셀(cell)은 전기화학 장치로 양극과 음극, 전해액을 가지는 전기 에너지원으로 축전지(battery)의 기본 구성 요소이다. 3. j.1항에서 '1차 셀'은 다른 에너지원에 의해 충전되도록 설계되지 않은 '셀'이다.	j.2. 293 K (20 °C)에서 350 Wh/kg 이하의 에너지 밀도를 갖는 '2차 셀'; 주: j항은 단일 셀 배터리를 포함하여 배터리를 통제하지 않는다. 기술해설: 1. j항에서 에너지 밀도(Wh/kg)는 공칭 전압에 공칭 용량(Ah)을 곱한 값을 질량(kg)으로 나누어 계산한다. 공칭 용량이 기재되어 있지 않을 경우에는 공칭 전압의 제공에 방전시간(h)을 곱한 값을 방전 부하(Ω)와 질량(kg)으로 나누어 계산된다. 2. j항에서 '셀(Cell)은 전기화학 장치로 양극과 음극, 전해액을 가지는 전기 에너지원으로 축전지(battery)의 기본 구성 요소이다. 3. j.1항에서 '1차 셀'은 다른 에너지원에 의해 충전되도록 설계되지 않은 '셀'이다.

통제번호	개정 전	개정 후
	4. j.2항에서 '2차 셀'은 외부 전기 에너지원에 의해 충전되도록 설계된 '셀'이다.	4. j.2항에서 '2차 셀'은 외부 전기 에너지원에 의해 충전되도록 설계된 '셀'이다.
22	k. "초전도" 전자석과 솔레노이드로서 1분 이내에 완전히 충전하거나 또는 방전시키도록 "전용설계"된 것으로서 다음의 특성을 모두 갖는 것: 주: k항은 의료용 자기공명영상장치(<u>magnetic resonance imaging, MRI</u>)를 위해 "전용설계"된 "초전도" 전자석이나 솔레노이드는 통제하지 않는다.	k. "초전도" 전자석과 솔레노이드로서 1분 이내에 완전히 충전하거나 또는 방전시키도록 "전용설계"된 것으로서 다음의 특성을 모두 갖는 것: 주: k항은 의료용 자기공명영상장치(<u>Magnetic Resonance Imaging, MRI</u>)를 위해 "전용설계"된 "초전도" 전자석이나 솔레노이드는 통제하지 않는다.
22	k.1. 방전 중 전달된 최대 에너지를 방전 지속 시간으로 나눈 값이 분당 500 kJ 이상인 것	k.1. 방전 중 전달된 최대 에너지를 방전 지속 시간으로 나눈 값이 분당 500 kJ 이상인 것
22	k.3. 정격 자기유도(<u>magnetic induction</u>)가 8 T를 초과하는 것 또는 "총 전류밀도"(<u>overall current density</u>)가 300 A/mm ² 를 초과하는 것	k.3. 정격 자기유도(<u>Magnetic induction</u>)가 8 T를 초과하는 것 또는 "총 전류밀도"(<u>Overall current density</u>)가 300 A/mm ² 를 초과하는 것
22	m. 세라믹 금속 구조의 수소/수소 동위원소 사이러트론(<u>thyatron</u>)으로 최대정격전류가 500 A 이상인 것	m. 세라믹 금속 구조의 수소/수소 동위원소 사이러트론(<u>Thyatron</u>)으로 최대정격전류가 500 A 이상인 것
22	o. 태양 전지, CIC(<u>cell-interconnect-coverglass</u>) 조립품, 태양 패널 및 태양 어레이로 "우주용"이며 별표 2 3A001.e.4에 의해 통제되지 않는 것	o. 태양 전지, CIC(<u>Cell-Interconnect-Coverglass</u>) 조립품, 태양 패널 및 태양 어레이로 "우주용"이며 별표 2 3A001.e.4에 의해 통제되지 않는 것
25	b.1.m. 다음 특성 중 하나를 갖는 "단일칩(<u>monolithic</u>) 집적 회로"의 수리 또는 트리밍을 위해 "레이저"를 사용하는 "저장 프로그램 제어" 장비:	b.1.m. 다음 특성 중 하나를 갖는 "단일칩(<u>Monolithic</u>) 집적 회로"의 수리 또는 트리밍을 위해 "레이저"를 사용하는 "저장 프로그램 제어" 장비:
	b.2.f. 정렬(<u>align</u>)과 노출 스텝-반복(<u>step & repeat</u>)(웨이퍼에 직접 스텝) 또는 스텝-스캔(<u>step & scan</u>)(스캐너) 장비로서 사진광학(<u>photo-optical</u>) 또는 X선(X-ray) 방법을 사용하여 웨이퍼를 가공하기 위한 것으로서 다음 중 하나의 특성을 갖는 것:	b.2.f. 정렬(<u>Align</u>)과 노출 스텝-반복(<u>Step & repeat</u>)(웨이퍼에 직접 스텝) 또는 스텝-스캔(<u>Step & scan</u>)(스캐너) 장비로서 사진광학(<u>Photo-optical</u>) 또는 X선(X-ray) 방법을 사용하여 웨이퍼를 가공하기 위한 것으로서 다음 중 하나의 특성을 갖는 것:
26	b.4.a. 18 GHz를 초과하는 주파수에서 시험할 수 있고, 디스크리트 반도체(<u>discrete semiconductor</u>) 장치 및 캡슐화 되지 않은 다이를 시험하기 위해 "전용설계"된 "저장 프로그램 제어" 장비	b.4.a. 18 GHz를 초과하는 주파수에서 시험할 수 있고, 디스크리트 반도체(<u>Discrete semiconductor</u>) 장치 및 캡슐화 되지 않은 다이를 시험하기 위해 "전용설계"된 "저장 프로그램 제어" 장비
27	193 ~ 370 nm 파장에서 사용하기 위해 특별히 조정(최적화)된 반도체 리소그래피용으로 설계된 양성 레지스트	193 ~ 370 nm 파장에서 사용하기 위해 특별히 조정(최적화)된 반도체 리소그래피용으로 설계된 양성 레지스트
44	a. 영상증배관(<u>image intensifier tubes</u>)과 이것의 "전용설계"된 구성품으로서 다음의 것:	a. 영상증배관(<u>Image intensifier tubes</u>)과 이것의 "전용설계"된 구성품으로서 다음의 것:
48	b.3.b. 초당 1 x 10 ⁶ magnetic flux quanta의 자기장 슬루율(slew rate)을 갖고 동작할 수 있게 설계된 것;	b.3.b. 초당 1 x 10 ⁶ Magnetic flux quanta의 자기장 슬루율(Slew rate)을 갖고 동작할 수 있게 설계된 것;
	b.3.d. 온도 계수가 0.1 magnetic flux quantum/K 보다 작은 것	b.3.d. 온도 계수가 0.1 Magnetic flux quantum/K 보다 작은 것
49	a. 정적 정확도가 100 microgal 미만인 것;	a. 정적 정확도가 100 Microgal 미만인 것;

통제번호	개정 전	개정 후
	또는	또는
52	a.1. 자유전자 레이저 자석 위글러(wiggler);	a.1. 자유전자 레이저 자석 위글러(Wiggler);
53	500 mm보다 낮은 '비트 길이(beat length)'를 갖도록 구조적으로 수정된 별표 2 6A002.d.3 에 의해 통제되지 않는 광검출섬유(optical sensing fibers) 또는 몰분율(mole fraction) 6 % 이상의 아연을 갖고 6C002.b에 명시되어 있지 않은 광센서 물질	500 mm보다 낮은 '비트 길이(Beat length)'를 갖도록 구조적으로 수정된 별표 2 6A002.d.3 에 의해 통제되지 않는 광검출섬유(Optical sensing fibers) 또는 몰분율(Mole fraction) 6 % 이상의 아연을 갖고 6C002.b에 명시되어 있지 않은 광센서 물질
54	b. 99.999 % 이상의 순도를 갖고 있는, 타물질 첨가 벌크 불소 화합물로 만들어진 광섬유 프리폼(preform)으로서 아래 참고품목에서 통제되는 광섬유 제조를 위해 “전용설계”된 것	b. 99.999 % 이상의 순도를 갖고 있는, 타물질 첨가 벌크 불소 화합물로 만들어진 광섬유 프리폼(Preform)으로서 아래 참고품목에서 통제되는 광섬유 제조를 위해 “전용설계”된 것
65	1. 다음 특성을 갖도록 설계된 해양 보일러: 1.1. 가열로(furnace) 입방 피트 당 시간당 190,000 BTU 이상의 열 방출 속도(최대 등급) 또는	1. 다음 특성을 갖도록 설계된 해양 보일러: 1.1. 가열로(Furnace) 입방 피트 당 시간당 190,000 BTU 이상의 열 방출 속도(최대 등급) 또는